

**关键指标**

- 频率: 8~11GHz
- 增益: 24dB
- 饱和输出功率: 42dBm
- 功率附加效率: 36%
- 工作电压: +8V
- 工作电流: 3.3A
- 芯片尺寸: 4.38mm×4.1mm×0.1mm

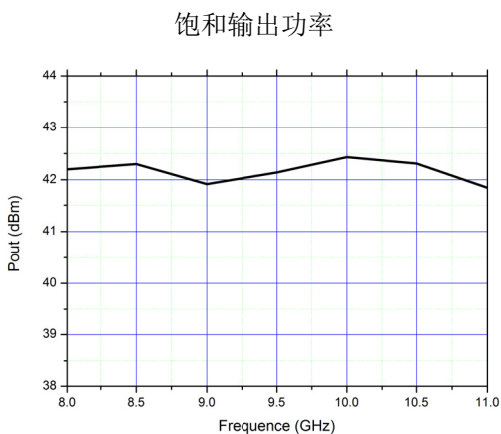
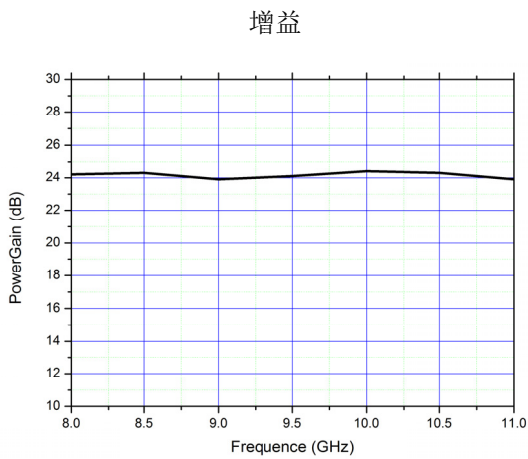
**产品简介**

HG135FA 是一款 8~11GHz 功率放大器芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 增益为 24dB, 饱和输出功率为 42dBm, 功率附加效率为 36%。

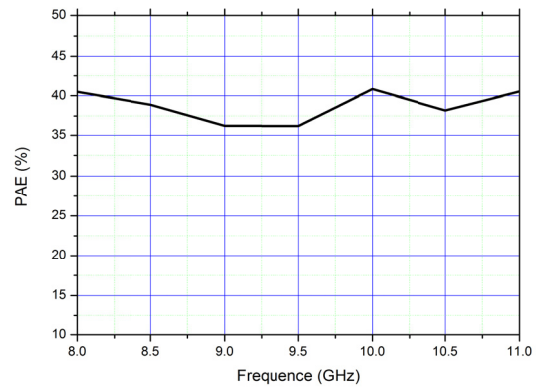
**电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=+8V, I<sub>dd</sub>=3.3A)**

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	8~11		
增益(dB)	-	24	-
输入回波损耗(dB)	-	9.5	-
输出回波损耗(dB)	-	9.5	-
饱和输出功率(dBm)	-	42	-
功率附加效率	-	36%	-
二次谐波抑制(dBc)	40	-	-

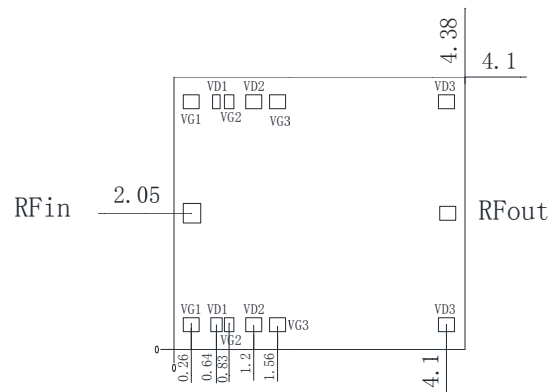
**典型测试曲线**



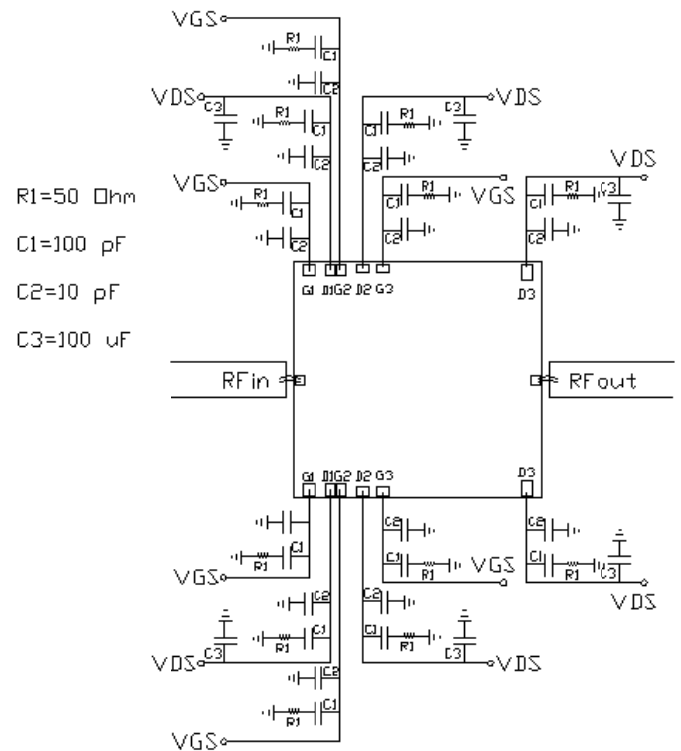
**饱和点功率附加效率**



**外形和端口尺寸 (mm)**



**推荐装配图**



**绝对额定最大值**

工作电压	10V
最大输入功率	+28dBm
工作温度	-55℃~85℃
存储温度	-65℃~150℃

**注意事项**

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 50 $\mu$ m 双金带键合，建议金带长度 250~400 $\mu$ m；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。